

## C2645ASG

### General Description (概述)

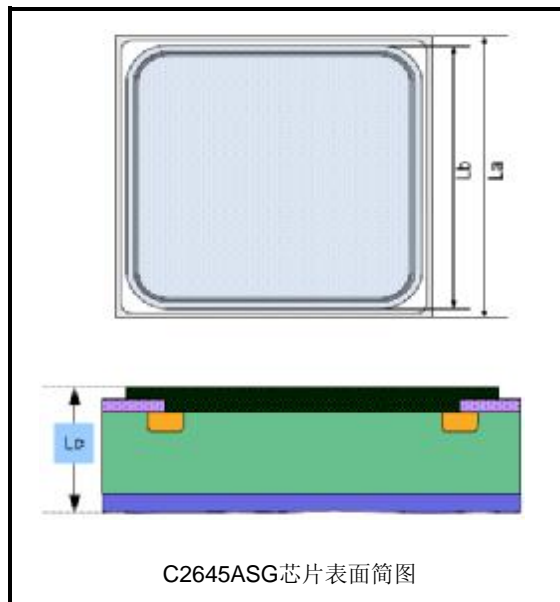
C2645ASG using silicon extension process manufacturing; Low Vf and high efficiency.

C2645ASG是采用硅外延工艺制造的肖特基二极管芯片；低正向压降且高效率。

All of these Schottky Diodes are designed for applications such as Rectifier, Reverse polarity protection circuit.

该产品广泛用于整流、极性保护电路等。

Items (项目)	Description (描述)
Wafer Size 硅片尺寸	5 Inch
General Parameters 主要参数	45V 1A
Chip Size 管芯尺寸(La)	670 μm
Pad Size 压点尺寸(Lb)	580 μm (Typical)
Chip Thickness 芯片厚度(Lc)	280 ± 20 μm
Surface Metal 正面金属	Ag
Backside Metal 背面金属	Ag
Cutting Street 划片道尺寸	40 μm



### Absolute Maximum ratings (极限参数, Ta=25°C)

Parameter 参数	Symbol 符号	Value 额定值	Units 单位
DC Blocking Voltage 最大直流阻断电压	$V_{RRM}$	45	V
Average Rectified Forward Current 正向平均整流电流	$I_{FAV}$	1	A
Nonrepetitive Peak Surge Current@8.3mS 正向峰值浪涌电流	$I_{FSM}$	40	A
Operating Junction Temperature 最高工作结温	$T_J$	125	°C
Storage Temperature 存储温度	$T_{STG}$	-40~125	°C

### Electrical specification (电参数规格, Ta=25°C)

Parameter 参数	Symbol 符号	Test Conditions 测试条件	Min 最小值	Max 最大值	Typ 典型值	Units 单位
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压	$V_{BR}$	$I_R=100\mu A$	45	-	-	V
Forward Voltage 正向压降	$V_F$	$I_F=1A$	-	0.53	0.495	V
Reverse Leakage Current 反向漏电流	$I_R$	$V_R=45V$	-	50		μA

声明:

- 1、扬州国宇保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- 2、划片损失及崩边不能超出划片道给定尺寸范围。
- 3、当测试温度变化参数亦会有所调整。